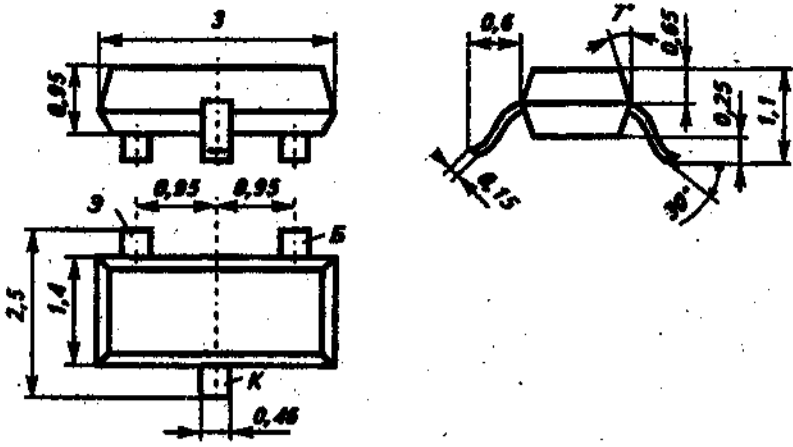


□ 2Т368А9, 2Т368Б9, КТ368А9, КТ368Б9

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п. Предназначены для применения в усилительных схемах. Выпускаются в миниатюрном пластмассовом корпусе, тип корпуса КТ-46. Масса транзистора не более 0,01 г.



Электрические параметры

Коэффициент шума при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 10 мА$, $f = 60 МГц$, не более	3,3 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 1 В$, $I_э = 10 мА$:	
$T = +25^{\circ}C$	50...300
$T = +100^{\circ}C$	40...500
$T = -60^{\circ}C$	25...300
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 10 мА$, $f = 100 МГц$, не менее	9
Граничное напряжение при $I_э = 10 мА$, не менее	15 В
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого сигнала при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 10 мА$, $f = 1 кГц$, не более	6 Ом
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 10 мА$, $f = 30 МГц$, не более	0,015 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5 В$, $f = 10 МГц$, не более	1,7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 1 В$, $f = 10 МГц$, не более	3 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 15 В$, не более:	
$T = +25^{\circ}C$	0,5 мкА
$T = +100^{\circ}C$	5 мкА
$T = -60^{\circ}C$	0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4 В$, $T = +25^{\circ}C$, не более	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор-база при $t_n < 0,5 мс$, $Q > 2$	20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{эб} = 3 кОм$	15 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{эб} = 3 кОм$, $t_n < 0,5 мс$, $Q > 2$	20 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	30 мА
Импульсный ток коллектора	60 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ :	
$T = -60...+50^{\circ}C$	0,1 Вт
$T = +100^{\circ}C$	0,025 Вт
Температура р-п перехода	+135 $^{\circ}C$
Температура окружающей среды	-60 $^{\circ}C...+100^{\circ}C$

¹При $T = +50...+100^{\circ}C$ постоянная мощность коллектора снижается по линейному закону. Допустимое значение статического потенциала не более 200 В. Собственная резонансная частота 5 кГц. Работа транзистора в режиме "оборванной базы" категорически запрещается. При работе с транзисторами должны быть приняты меры по устранению возможностей по самовозбуждению транзисторов. Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с обратными токами коллектора и эмиттера во всем диапазоне температур.

